

InGaAs фотодетекторный чип 1740 нм, 500 мкм — техническое описание

P/N : WIR3-500

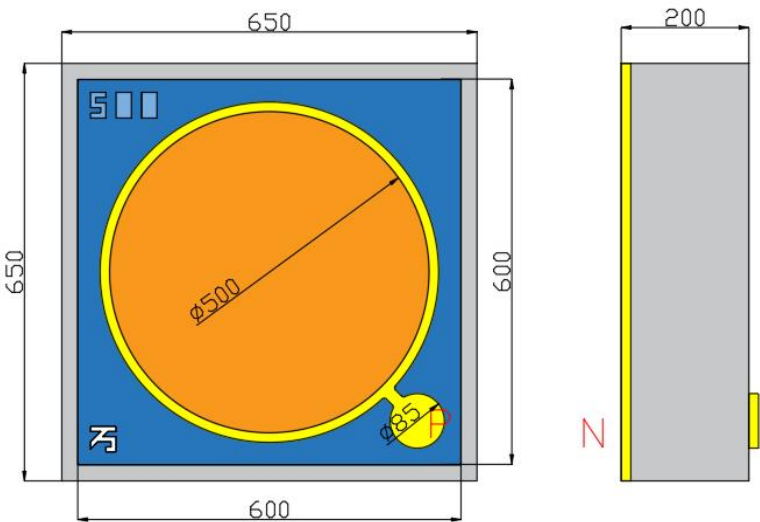
Особенности

Высокая чувствительность; низкий темновой ток; спектральная чувствительность 900–1740 нм

Структура

InGaAs/InP PIN-чип. Р-электрод (анод): золото.

N-электрод (катод): золото.



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	-	500	-	мкм
Ширина чипа	-	650	-	мкм
Длина чипа	-	650	-	мкм
Высота чипа	180	200	220	мкм
Размер контактной площадки	80	85	90	мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Темновой ток	Id	Vr=-5V	-	0.2	1	нА
Емкость	Cp	Vr=-5V	-	15	25	пФ
Чувствительность	R	@1654 nm	0.9	1	-	А/Вт
Рабочий диапазон длин волн	λ		900	1650	1740	нм

Примечание: ESD (HBM) > 800 В

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Рабочая температура	от -40 °C до +85 °C
Температура хранения	от -55 °C до +125 °C
Прямой ток	10 мА